

■シンポジウム一覧

開催日	時間	会場	テーマ	世話人(所属)
3/22 (水)	10:00～16:35	7号館 4F 741-ZA (29)	半導体のプロセス・デバイス・回路のモデリングとシミュレーション	小田中紳二 (阪大サイバーメディアセンター)
	13:00～16:50	7号館 2F 724-T (29)	真空を利用した分析機器—質量分析計	高橋 直樹 (ア ル バ ッ ク)
	13:00～17:20	6号館 3F 633-ZK (29)	薄膜・表面物理分科会企画 「ナノサイエンスとしてのカーボンナノチューブ研究」	市川 昌和 (東 大) 片山 光浩 (阪 大)
	13:30～16:35	6号館 2F 621-ZG (29)	「応用物理とものづくり～応用物理学と産業界の一層の連携を目指して～」	増田 淳 (産 総 研) 澤邊 厚仁 (青 学 大)
3/23 (木)	13:00～17:05	3号館 1F 312-ZN (30)	光インターコネクション —携帯内光接続から次世代 Super Computer 応用へ向けて—	工藤 耕治 (NEC システムデバイス研究所)
	13:00～17:20	6号館 B1F 6B2-ZF (30)	光技術と技術経営 (II) —国際競争力回復を目指して—	石井 弘之 (キ ヤ ノ ン)
	13:00～17:35	6号館 3F 633-ZK (30)	日本学術振興会ナノプローブテクノロジー第 167 委員会企画 「走査プローブ顕微鏡のロードマップ」	長谷川修司 (東 大) 森田 清三 (阪 大)
	13:00～17:45	6号館 2F 621-ZG (30)	電子デバイスを目指したバイオテクノロジーとナノテクノロジーの融合 —融合手法と今後の展開—	寒川 誠二 (東 北 大・流 体 科 学 研) 山下 一郎 (松 下 電 器・先 端 技 術 研)
	13:10～17:30	3号館 1F 311-ZM (30)	スピントロニクスデバイスへ向けての最前線	宮崎 照宣 (東 北 大) 新田 淳作 (東 北 大)
	13:30～16:40	8号館 1F 814-A (29)	諸外国の物理教育の現状と動向 —国際会議の役割は?—	中澤 達夫 (長 野 高 専)
	13:30～17:10	8号館 1F 815-B (29)	広島・長崎原爆放射線量新評価システム DS02 と環境放射能計測技術	若林 源一郎 (九 大・工・エ ネ ル ギ ー 量 子) 山内 知也 (神 戸 大・海 事 科 学 部)
	13:30～18:00	6号館 B1F 6B1-ZE (30)	超伝導分科会企画 「発見から 20 年、高温超伝導研究の最前線」	塚本 晃 (日 立 基 礎 研)
3/24 (金)	9:00～17:20	5号館 B1F 小講堂-ZL (32)	応用物理学 M&BE 日本分光学会テラヘルツ分光部会 テラヘルツ電磁波技術研究会 合同企画 「有機・生体分子の分光センシングの新潮流： テラヘルツ波と表面波による分光法」	味戸 克裕 (N T T 物 性 基 礎 研) 田畑 仁 (阪 大) 谷 正彦 (阪 大) 廣本 宣久 (静 岡 大) 西本 尚弘 (島 津 製 作 所)
	13:00～16:50	8号館 1F 814-A (31)	衝撃現象と極限環境プロセス	松本 仁 (防衛大 機能材料工学科)
	13:00～17:00	3号館 4F メソゾナル-ZQ (32)	研究開発環境の多様性と評価：企業における現状とその課題	福島理恵子 (東芝 研究開発センター)
	13:00～17:00	7号館 4F 744-ZD (31)	光のスペクトルに着目した光波センシング	石井 行弘 (東 理 大) 小野寺理文 (能 開 大) 田中 哲 (防 衛 大)
	13:30～17:25	8号館 2F 821-D (31)	シリコン光エミッタ	金光 義彦 (京 大) 深津 晋 (東 大)
	13:00～17:25	3号館 2F 321-ZP (32)	有機光・電子機能媒質の構造化：光波の多様な制御を目指して	福田 隆史 (産 総 研・光 技 術) 佐々 高史 (理 研・超 分 子 科 学)
	13:00～17:50	6号館 B1F 6B2-ZF (31)	結晶工学分科会、シリコンテクノロジー分科会共同企画 「超高速・低消費電力トランジスタを実現する 結晶材料・プロセス・デバイス技術」	小野 春彦 (J F C C) 金田千穂子 (富 士 通 研)
	13:00～18:15	6号館 3F 633-ZK (32)	翼を広げる分極反転光デバイス	栗村 直 (物 材 機 構)
	13:30～17:00	3号館 1F 311-ZM (32)	ランダム系フォトエレクトロニクスの進展	田中 啓司 (北 大 工 研)
	13:00～17:25	8号館 2F 820-C (31)	エネルギーデバイスの革新が拓く持続可能社会実現への道 —応用物理学の新たな貢献に向けたビジョン・提言—	岸田 俊二 (N E C 中 研)
	13:30～17:30	6号館 2F 621-ZG (32)	酸化亜鉛薄膜における次元制御による物性設計	山本 哲也 (高 知 工 科 大)
	13:30～17:35	6号館 B1F 6B1-ZE (31)	メートル級大面積プラズマプロセスの現状と展望	豊田 浩孝 (名 大 工)
3/25 (土)	9:00～17:45	6号館 B1F 6B2-ZF (33)	日本学術振興会第 161 委員会・第 145 委員会・第 175 委員会合同企画 「Si バルク結晶太陽電池の現状と課題」	中嶋 一雄 (東 北 大 金 研) 柿本 浩一 (九 大 応 力 研) 山田 明 (東 工 大 量 エ レ 研)
	13:00～17:45	8号館 2F 820-C (33)	励起ナノプロセスの展望	篠塚 雄三 (和 歌 山 大 シ ス テ ム 工)
	13:00～18:00	6号館 3F 633-ZK (33)	生命の世界・視えるものと観たいもの —生体計測・SPMの可能性—	繁野 雅次 (S I I・ナノテクノロジー) 古川 一暁 (N T T) 田中 敬二 (九 大)
	13:30～18:00	5号館 B1F 小講堂-ZL (33)	ナノ光電子機能を探索する	堀 裕和 (山 梨 大 院 医 工) 齋木 敏治 (慶 大 理 工) 小林 潔 (東 工 大 院 理 工)

() 内の数字はプログラム掲載頁。

■ 1. 放射線・プラズマエレクトロニクス 分科内総合講演 「プラズマエッチングの限界と展開」(招待講演)

開催日	時間	会場	テーマ	講演者(所属)
3/22 (水)	12:00～12:30	5号館 B1F 小講堂-ZL (37)	中性粒子ビームによる究極のトップダウン加工 —ダメージフリープロセスを目指して—	寒川 誠二 (東 北 大)
	13:30～14:00		プラズマサイエンスブレイクスルーによる究極のエッチング技術	堀 勝 (名 大)
	14:00～14:30		プラズマエッチングに対する要求と今後の方向	酒井伊都子 (東 芝 セ ミ コ ン)
	14:30～15:00		ゲートエッチングの微細化および量産の課題と今後の展望	伊澤 勝 (日 立 中 研)

*一般講演/9:45～12:00, 15:15～16:45あり

■ 11. 半導体 A (シリコン) 分科内総合講演 「Cu/Low-k 多層配線技術の現状と今後の課題」(招待講演)

開催日	時間	会場	テーマ	講演者(所属)
3/23 (木)	10:00～10:05	8号館 2F 820-C (87)	はじめに: Cu/Low-k、何が問題で何が解っているか?	小川 真一 (松 下 電 器 半 導 体 社)
	10:05～10:35		45nm 対応 Cu/Low-k インテグレーション技術	松永 範昭 (東 芝)
	10:35～11:05		45nm 世代 LSI 対応低酸素 Cu 配線技術	多田 宗弘 (N E C)
	11:05～11:35		45 / 65nm ノード対応 Air-Gap 配線プロセス	野口 純司 (日 立)
	11:35～12:05		カーボンナノチューブ配線ビア技術	栗野 祐二 (富 士 通 研)
	13:00～13:30		ポストキュアによるポーラス Low-k 膜の物性制御とそのメカニズム	伊藤 文則 (N E C)
	13:30～14:00		Low-k 材料実用化技術: 構造と物性	渡邊 桂 (東 芝)
	14:00～14:30		Low-k 膜の非破壊評価技術 —プラズマダメージによる表面高密度層形成と孔径分布—	秦 信宏 (産 総 研)
	14:30～15:00		ポーラス Low-k 膜の低ダメージエッチング、アッシング技術	曾田 栄一 (S e l e t e)
	15:00～15:30		Low-k 膜ダメージの TEM/V-EELS 法による評価	小川 真一 (松 下 電 器 半 導 体 社)
	15:45～16:15		CMP 薬液によるポーラスシリカ Low-k 膜の物性劣化と回復技術	石川 彰 (半 導 体 M I R A I - A S E T)
	16:15～16:45		Cu/ILD 界面バリア層の材料科学	小池 淳一 (東 北 大)
	16:45～17:15		ALD 薄膜バリアを用いた高信頼性 Cu 配線技術	森 健壹 (ル ネ サ ス テ ク ノ ロ ジ)
17:15～17:45	EBSF を用いた Cu 配線の結晶解析技術と配線信頼性	廣瀬 幸範 (ル ネ サ ス テ ク ノ ロ ジ)		

■ 合同セッション G「量子情報の基礎と応用」 分科内総合講演 「光子数識別技術の現状と将来展望」(招待講演)

開催日	時間	会場	テーマ	講演者(所属)
3/22 (水)	13:00～13:45	7号館 4F 744-ZD (116)	超伝導転移端マイクロカロリメータを用いた単一光子計測技術	福田 大治 (産 総 研)
	13:45～14:30		窒化ニオブ(NbN)を用いた超伝導単一光子検出器の開発	王 鎮 (情 通 機 構)
	14:45～15:30		光子数検出器と線形光学量子回路	竹内 繁樹 (北 大)
	15:30～16:15		高感度光検出技術 光子数識別に向けて	藤原 幹生 (情 通 機 構)

■ 12. 半導体 B (探索的材料・物性・デバイス) 分科内招待講演

開催日	時間	会場	テーマ	講演者(所属)
3/26 (日)	13:00～13:30	8号館 2F 820-C (93)	窒化鉄薄膜の成長と自動車用磁気センサーへの応用について	中村 高遠 (静 岡 大)
3/22 (水)	14:00～14:30	8号館 1F 815-B (95)	GaN 電子デバイス開発における物性研究 —結晶評価からプロセス、デバイス物理まで—	塩島 謙次 (N T T フォトニクス研)
3/24 (金)	13:00～13:30	1号館 2F 123-ZR (97)	化合物薄膜太陽電池の最近の進展 —CIS 太陽電池を中心に—	和田 隆博 (龍 谷 大)

■ 14. 非晶質・微結晶 分科内招待講演 「薄膜トランジスタ用プラズマ CVD 装置の最近の進展」

開催日	時間	会場	テーマ	講演者(所属)
3/23 (木)	13:30～14:00	7号館 3F 734-Y (108)	大型 TFT-LCD 用第 8 世代 PECVD 装置の最新技術	竹原 尚子 (AKT, an Applied Materials comp)
	14:00～14:30		内部アンテナ型 ICPCVD による μ c-Si:H の大面積高速成膜技術の開発	林 司 (日 新 電 機)

■ 光学論文賞受賞記念講演

開催日	時間	会場	テーマ	講演者(所属)
3/23 (木)	13:45～14:25	5号館 B1F 小講堂-ZL (33)	パラメトリック蛍光対動的制御による単一光子源の実現	竹内 繁樹 (北 大)
	14:25～15:05		結像光学系を用いた半導体パターン位置検出における像歪の低減	菅谷 綾子 (ニ コ ン)

() 内の数字はプログラム掲載頁.